



美光推出增加服务器内存容量和提升性能的新方法

新的低负载模块尺寸使内存容量增至三倍，使带宽比标准的寄存式模组提高57%

Boise, Idaho , 2009年7月30日 –

美光科技股份有限公司（纽约证券交易所：MU）今日宣布生产出业内首个DDR3低负载双列直插内存模块(LRDIMM)，并将于今年秋季开始推出16GB版本的样品。通过减少服务器内存总线上的负载，美光的[LRDIMM](#)可用以支持更高的数据频率并显著增加内存容量。

新的LRDIMM将采用美光先进的1.35v 2Gb 50nm

的DDR3内存芯片制造。由于芯片的高密度和业内领先的小尺寸，使美光能够轻松并具成本效益地增加服务器模块的容量。美光的2Gb 50nm DDR3产品目前正在进行客户认证，将很快进行大量生产。

如今多数中端企业服务器每系统使用大约32GB的DRAM内存，但根据Gartner公司近期的一份报告（2009年5月），此数字预计在2012年将增至三倍以上。随着服务器制造商继续利用多核处理器和数据中心选择高效的虚拟化技术，内存要求达到前所未有的高度。通过增加服务器系统具备的可用内存，系统能够同时运行更多的程序、更有效地处理更大的数据文件，通常呈现出更好的整体系统性能。

美光的LRDIMM目前使用Inphi近期推出的隔离内存缓冲(iMB)芯片而非寄存器，以在内存和处理器之间传输数据时减少总线负载。相较于目前标准的DDR3服务器模块 - 寄存式DIMM (RDIMM)，美光新的双排LRDIMM模块可减少此负载50%，四排LRDIMM模块则可减少75%。通过减少总线负载，美光的LRDIMM使服务器能够处理更高的数据频率，从而提高整体系统性能和支持更多的模块数量以获得更大的系统内存容量。

目前使用[RDIMM](#)的典型服务器系统每个处理器最多可以容纳3个四排16GB

RDIMM模块。不过，同样的系统每处理器最多可以支持9个四排16GB

LRDIMM，使内存容量从48GB增加到144GB。与RDIMM的性能水平相比较，美光的16GB

LRDIMM增加系统内存带宽57%。由于服务器功耗仍是客户的首要考虑，美光的LRDIMM也将以业内最低的1.35伏电压运作。

美光DRAM市场营销副总裁Robert

Feurle说：“随着虚拟化的兴起，我们新的16GB模块使客户能够方便地扩大他们的内存容量。传统的RDIMM由于其负载情况限制了可以容纳的内存数量，而LRDIMM通过减少模块负载消除了该问题。由于我们的LRDIMM设计采用美光新的低功耗2Gb 50nm

DDR3芯片，这减少了模块芯片数量，因此我们能够为客户提供更具成本效益和更高效的方法来提高服务器内存容量和性能，同时还降低功耗水平。”

Inphi市场营销副总裁Paul

Washkewicz说：“采用此内存技术方式将进一步实现服务器虚拟化和云计算。此技术为数据中心服务器提供迫切需要的更大带宽和内存容量。”

IDT 企业计算部副总裁兼总经理Mario Montana说：“作为AMB+ 和 DDR3

寄存器/PLL这样低功耗内存接口设备的领先供应商，IDT很高兴再次将我们经过行业证明的技术和专长应用到这个针对DDR3

LRDIMM的新类别的内存缓存。我们很高兴与美光以及我们的生态系统伙伴合作，为高性能计算市场实现创新的解决方案。”

产品供货

目前美光已经在向部分选定公司提供8GB LRDIMM的样品。16GB LRDIMM的量产预计将于2010年开始。

相关链接

了解美光最新新闻的其他方法有：

- 美光创新博客：www.micronblogs.com
- 美光Twitter：<http://twitter.com/microntechpr>
- 美光 RSS：www.micron.com/about/news/rssfeeds

关于美光公司

美光科技股份有限公司（Micron Technology, Inc.）是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一。通过全球化的运营，美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、其他半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。美光公司普通股代码为MU，在纽约证券交易所（NYSE）交易。如需了解美光科技有限公司的详细情况，请访问：www.micron.com。

Micron（美光）和美光环绕标志是美光科技股份有限公司（Micron Technology, Inc.）的商标。所有其他商标属其各自所有人财产。

本新闻稿包含有关美光LRDIMMs和2Gb 50nm

DDR3生产的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与这些前瞻性陈述所含内容产生显著差异。请参考美光公司在并表基础上不时向美国证券交易委员会呈报的文件，特别是公司最新的10-K表和10-Q表。这些文件含有并明确了可能导致公司在合并报表基础上的实际业绩与我们的前瞻性陈述中所含内容产生重大差异的重要因素（参见“已知因素”章节）。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们不能对未来业绩、活动水平、表现或成绩做出保证。本新闻稿发布日期之后，我们不会为了使前瞻性陈述符合实际结果，而承担更新任何前瞻性陈述的责任。

图片/多媒体信息网址：<http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6018615&lang=en>

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

CONTACT:
Kirstin Bordner
Micron Technology, Inc.
208-368-5487
kbordner@micron.com